

特 許 協 力 条 約

PCT

REC'D 24 SEP 2004

WIPO

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条)

[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 144971-077	今後の手続きについては、様式PCT/ IPEA/ 416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/13849	国際出願日 (日.月.年) 29.10.2003	優先日 (日.月.年) 30.10.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> H01L21/205, C23C16/52		
出願人 (氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社		

- この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。  
法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。
- この報告には次の附属物件も添付されている。
  - ☐ 附属書類は全部で \_\_\_\_\_ ページである。
    - ☐ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙 (PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)
    - ☐ 第I欄4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
  - ☐ 電子媒体は全部で \_\_\_\_\_ (電子媒体の種類、数を示す)。  
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 国際予備審査報告の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☒ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 05.04.2004	国際予備審査報告を作成した日 01.09.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員)  今井 拓也	4 R 9169
電話番号 03-3581-1101 内線 3469		

様式PCT/ IPEA/ 409 (表紙) (2004年1月)

## 第 I 欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

- ☐ この報告は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎とした。  
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。
- ☐ P C T規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査
- ☐ P C T規則12.4にいう国際公開
- ☐ P C T規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

- ☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書  
 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付かで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付かで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲  
 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 P C T 1 9 条の規定に基づき補正されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付かで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付かで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面  
 第 \_\_\_\_\_ ページ／図、 出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ／図\*、 \_\_\_\_\_ 付かで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ／図\*、 \_\_\_\_\_ 付かで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル  
 配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

- |                          |                                |         |         |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 明細書                            | 第 _____ | ページ     |
| <input type="checkbox"/> | 請求の範囲                          | 第 _____ | 項       |
| <input type="checkbox"/> | 図面                             | 第 _____ | ページ / 図 |
| <input type="checkbox"/> | 配列表（具体的に記載すること）                |         |         |
| <input type="checkbox"/> | 配列表に関連するテーブル（具体的に記載すること） _____ |         |         |

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

- |                          |                                |         |       |
|--------------------------|--------------------------------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 明細書                            | 第 _____ | ページ   |
| <input type="checkbox"/> | 請求の範囲                          | 第 _____ | 項     |
| <input type="checkbox"/> | 図面                             | 第 _____ | ページ／図 |
| <input type="checkbox"/> | 配列表（具体的に記載すること）                |         |       |
| <input type="checkbox"/> | 配列表に関連するテーブル（具体的に記載すること） _____ |         |       |

\* 4. に該当する場合、その用紙に “superseded” と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	1-12	有 無
	請求の範囲		
進歩性(IS)	請求の範囲		有 無
	請求の範囲	1-12	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-12	有 無
	請求の範囲		

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

請求の範囲 1, 3-10, 12

文献1: JP 2001-144019 A (東京エレクトロン株式会社)  
2001.05.25 【0008】-【0029】【図1】-【図6】

には、複数の基板を保持する保持具と、保持具が搬入される反応容器と、反応容器に処理ガスを供給する処理ガス供給機構と、処理ガスの供給時に反応容器を加熱して基板に成膜処理を施す加熱機構を有する成膜装置において、1バッチ処理で処理が予定される基板の枚数データと処理ガスの流量パラメータの目標値データとを対応させた流量パラメータテーブルデータを予め測定し、当該データを記憶する流量パラメータテーブルデータ記憶部、パラメータデータに基づいてガス流量を制御する制御手段を備えた熱処理装置、また、温度テーブルデータによる制御を行うこと、ウェハの搭載枚数に応じた制御を行うこと、が記載されている。

文献2: JP 2000-340554 A (東京エレクトロン株式会社)  
2000.12.08

【0009】-【0026】【図1】-【図9】(A)(B)  
には、成膜速度を基準プロセスと略同じにするために成膜パラメータを制御する技術が記載されている。

文献1に記載されている発明において、プロセスの再現性向上の為に、文献2に記載された成膜速度に着目して制御することは、当業者にとって自明な事項である。

請求の範囲 2, 11

請求の範囲2, 11では、各バッチ処理で基板に成膜される薄膜についての平均膜厚を処理時間で割った最小値と最大値の差というパラメータを0.05nm/分と設定しているが、当該パラメータをどのような値に設定するかは当業者にとって必然的に到達するであろうものである。よって、請求の範囲2, 11は、当業者であれば文献1, 2から容易に想到し得たものである。

## 第VI欄 ある種の引用文献

## 1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
JP 2003-77782 A 「E, X」	14. 03. 2003	31. 08. 2001	

## 2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)
-----------------	------------------------------	--